

**M1FM3****30V 3A****特長**

- 小型 SMD
- 低  $V_F=0.46V$
- 低  $I_R=0.05mA$

**Feature**

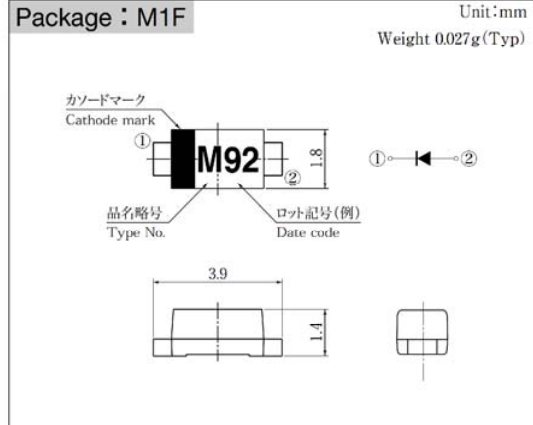
- Small SMD
- Low  $V_F=0.46V$
- Low  $I_R=0.05mA$

**用途**

- バッテリー逆接防止
- DC/DCコンバータ
- 携帯電話、パソコン

**Main Use**

- Reverse connect protection for DC power source
- DC/DC Converter
- Mobile phone, PC

**■外観図 OUTLINE**

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。  
For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

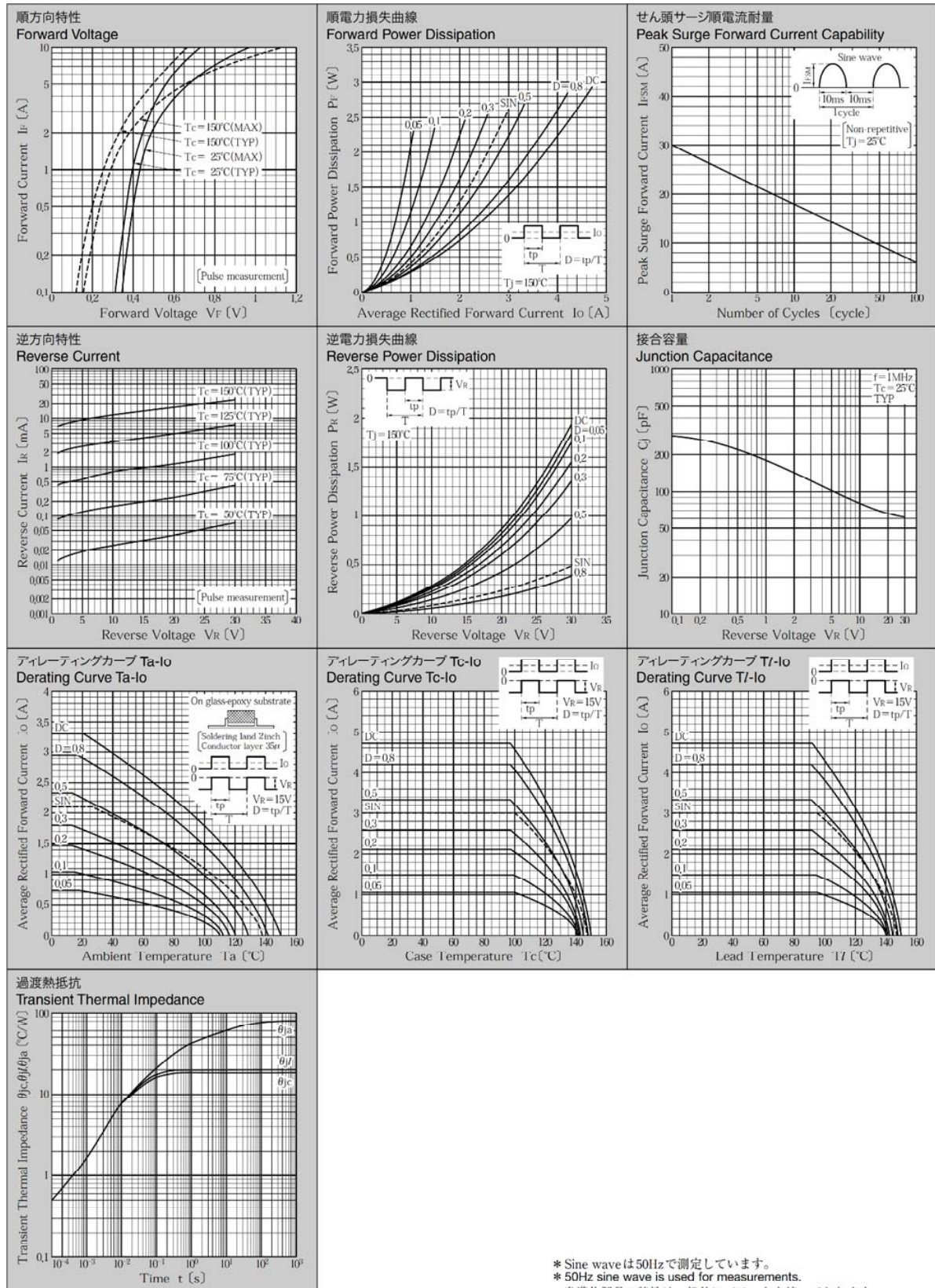
**■定格表 RATINGS****●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合  $T_c = 25^\circ C$ )**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M1FM3	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$			-55~150	$^\circ C$
接合部温度 Operation Junction Temperature	$T_j$			150	$^\circ C$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{RM}$			30	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	$I_O$	50Hz正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	$T_a = 25^\circ C$ プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	2.1	A
			$T_c = 100^\circ C$	3.0	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ C$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ C$		30	A

**●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合  $T_c = 25^\circ C$ )**

順電圧 Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 0.5A$ , パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.40	V
		$I_F = 1.5A$ , パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.46	
逆電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R = V_{RM}$ , パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.05	mA
接合容量 Junction Capacitance	$C_j$	$f = 1MHz, V_R = 10V$	TYP 80	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{jc}$	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 18	$^\circ C/W$
	$\theta_{jl}$	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 20	
	$\theta_{ja}$	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to ambient, On glass-epoxy substrate	MAX 80	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



\* Sine wave は50Hzで測定しています。  
\* 50Hz sine wave is used for measurements.  
\* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。  
\* Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.